

ПЛАЗМЕННО-ДУГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

УДК 621.745.5:669.15/26

ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЙ ПЕРЕПЛАВ ОТХОДОВ ТАНТАЛА

В. Р. Бурнашев

Исследовано влияние плазменно-дугового переплава (ПДГП) на кинетику удаления примесей из отходов tantalа. Определено, что изменение технологических режимов ПДГП приводит к интенсивному рафинированию tantalа от углерода, железа, молибдена и марганца. Отмечена перспективность переработки отходов tantalа способом ПДГП для получения компактных заготовок массой до 11 кг.

The effect of plasma-arc remelting (PAR) on kinetics of removal of impurities from titanium wastes was investigated. It was determined that change in technological conditions of PAR leads to the intensive refining of tantalum from carbon, iron, molybdenum and manganese. The prospects for recycling of tantalum wastes by the PAR method for producing compact billets of up to 11 kg mass were outlined.

Ключевые слова: плазменно-дуговая гарнисажная плавка; отходы; tantal; кинетика; удаление; примеси; заготовка

Тантал характеризуется весьма ценными свойствами — высокой температурой плавления, низким давлением паров и малой скоростью испарения при 1500...2000 °C, способностью к эмиссии и поглощению газов, что позволяет изготавливать из него детали электровакуумных приборов. Последнее свойство используют для поддержания глубокого вакуума в радиолампах и других электронных приборах [1–6].

Плавку tantalа применяют как технологическую операцию для достижения двух целей:

— получения компактных заготовок для последующей обработки [7];

— рафинирования металла от примесей [8].

Поскольку tantal имеет высокое сродство к кислороду и углероду, применение для его плавки оксидных материалов или графита приводит к сильному загрязнению примесями. Это оказывает отри-

цательное влияние на механические свойства tantalа, в частности на снижение пластичности. По этой причине плавку осуществляют в медных водоохлаждаемых тиглях.

Исходными материалами для выплавки слитков служат черновые металлы, полученные карбо- или алюмотермическим способами, спеченные штабики tantalа, а также отходы tantalового производства.

Важное значение имеет применение tantalа для изготовления конденсаторов. Здесь использована способность tantalа к образованию устойчивой оксидной пленки при электролитическом анодном окислении. Tанталовые элементы конденсаторов изготавливают из tantalовой фольги толщиной примерно 0,013 мм или из tantalового порошка, который прессуют и спекают при 2000 °C в пористые таблетки (пористость 30...50 %).

В случае применения твердого электролита таблетку после анодного окисления пропитывают раствором $Mn(NO_3)_2$ и нагревают для превращения нитрата в MnO_2 . После многократного повторения операции на пленке Ta_2O_5 образуется покрытие из MnO_2 . Затем таблетки покрывают электропроводным углеродом [4, 5]. После окончания эксплуатации конденсаторы подлежат утилизации.

Вовлечение в производство отходов tantalа в виде элементов конденсаторов имеет важное народнохозяйственное значение ввиду больших объемов утилизации военной и гражданской техники, выведенной из эксплуатации.



Рис. 1. Отходы радиодеталей, подготовленные к переплаву

© В. Р. БУРНАШЕВ, 2008



Утилизация отходов tantalа является очень трудоемкой операцией. Вначале конденсаторы освобождают от металлических капсул (рис. 1), а затем подвергают сплавлению.

Важное значение при переработке tantalовых деталей конденсаторов приобретает контроль за примесями химических элементов и соединений, используемых при их изготовлении (нержавеющая сталь, марганец, молибден, коллоидный углерод) [6]. Примеси из tantalа могут удаляться в атомарном состоянии (железо, кремний, алюминий, титан и другие металлы) и в молекулярном (азот и летучие оксиды типа CO , SiO_2 , NbO , TaO , Al_2O_3) [4–6].

В настоящей работе проведены эксперименты по исследованию влияния плазменно-дугового переплава (ПДП) на кинетику удаления примесей из tantalовых деталей конденсаторов.

Экспериментальные кинетические кривые испарения примесей в tantalе получали по данным опытов, выполненных с различной продолжительностью выдержки металла под плазмой. Опыты проводили на установке ОБ1957 в аргоне и гелии. Использовали медный водоохлаждаемый стол с десятью полусферическими лунками, размер которых выбран таким образом, чтобы зона анодного пятна закрывала зеркало жидкого металла.

Масса одного образца составила 50 г. Выдержка образца под плазмой в течение 180 с длилась до полного расплавления образца, следующего — 360 с, последнего — 720 с.

С применением методов спектрального и химического анализа определено, что основными примесями в исследуемых отходах tantalа являются железо, марганец, углерод и молибден.

В процессе исследований меняли такие технологические параметры, как ток и состав плазмообразующего газа. Следует отметить, что углерод, железо и молибден испаряются или всыпаются в виде включений в течение всего времени воздействия на образец плазмой. Увеличение тока от 650 до 750 А, а также применение в качестве плазмообразующего газа смеси аргона и гелия (в соотношении 1:1 по объему) приводит к увеличению скорости удаления

Химический состав tantalа исходного и переплавленного способом ПДП

№ пла- зы	Состав	Массовая доля элементов, %			
		Ta	Fe	Mn	Mo
1	Исходное	90,995	7,229	0,288	1,517
	После ПДП	98,820	0,572	Не обнару- женено	0,601
2	Исходное	98,387	0,723	0,337	0,567
	После ПДП	99,674	0,286	Не обнару- женено	0,078
3	Исходное	99,629	Не обнару- женено	*	0,371
	После ПДП	99,719	*	*	0,28

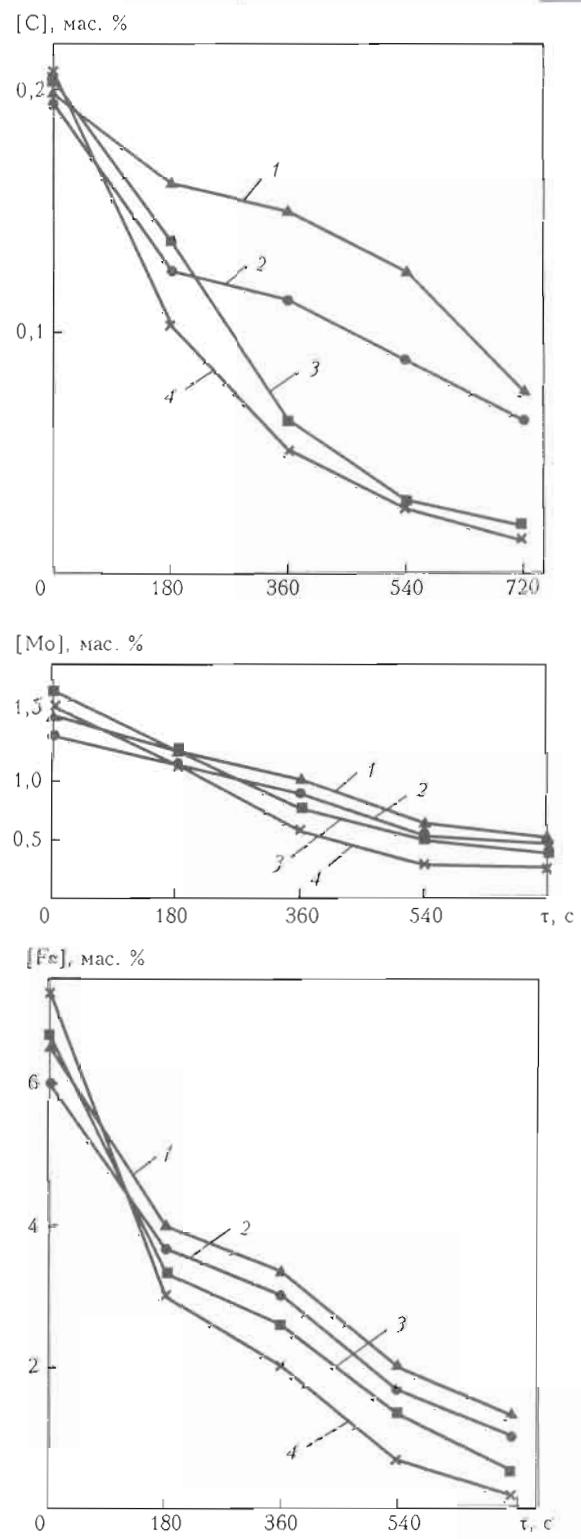


Рис. 2. Поведение примесей при переплаве отходов tantalа: 1 — аргон, $I = 650 \text{ A}$; 2 — аргон, $I = 750 \text{ A}$; 3 — аргон + гелий, $I = 650 \text{ A}$; 4 — аргон + гелий, $I = 750 \text{ A}$

примесей, о чем свидетельствуют наклон кинетических кривых (рис. 2).

Что касается кинетики испарения марганца, то установить какую-либо закономерность не удалось из-за его сильного испарения в самом начале расплавления. После воздействия плазмы на tantalевые образцы в течение 360 с марганец не обнаружен.

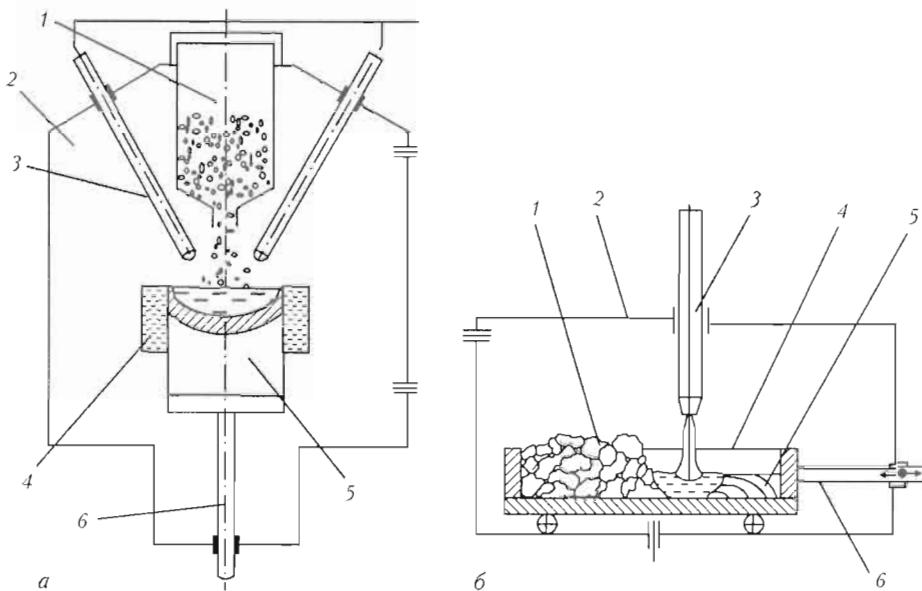


Рис. 3. Схемы установок УПП-3 (а) и ОБ1957 (б): 1 — шихта; 2 — плавильная камера; 3 — плазмотрон; 4 — кристаллизатор; 5 — слиток; 6 — механизм вытягивания слитка

Материалный баланс примесей показал, что при воздействии плазменной дуги на tantalевые элементы конденсаторов в течение 720 с происходит интенсивное рафинирование от углерода (в 10...12 раз), железа (в 15 раз), молибдена (в 3...5 раз) и марганца (полностью).

С учетом указанных результатов проведены эксперименты по получению плоских и круглых заготовок tantalа из отходов tantalевых конденсаторов. Компактирование отходов tantalа в круглую заготовку выполняли в плазменно-дуговой печи УПП-3, оснащенной проходным медным водоохлаждаемым кристаллизатором (рис. 3, а).

Плавку начинали с загрузки отходов на медную водоохлаждаемую затравку. Камеру печи откачивали вакуумно-дуговым насосом ВН2 до $1 \cdot 10^{-1}$ МПа. Затем рабочее пространство заполняли аргоном и расплавляли шихту. Расплавленный металл выдерживали под плазмой 25...30 мин для рафинирования от примесей. Масса одной засыпки составляла 1,2...1,5 кг. Затем металл охлаждали и делали следующую засыпку, повторяя эту операцию несколько

раз. В результате получили слитки tantalа диаметром 100 мм, массой 7...11 кг (рис. 4, а). При этом на компактирование и рафинирование tantalа от примесей расходуется от 9 до 15 кВт·ч/кг электроэнергии.

Переплав отходов tantalа в плоскую заготовку выполняли в печи ОБ1957 по схеме, приведенной на рис. 3, б. В плоский медный водоохлаждаемый кристаллизатор загружали отходы tantalевых конденсаторов. Толщина заготовки составляла 30...40 мм, масса одной порции — 8...9 кг.

При плавке по этой схеме в качестве плаズмообразующего газа использовали смесь аргона и гелия. Процесс начинали с расплавления ванны жидкого металла по ширине кристаллизатора. Затем кристаллизатор перемещали с небольшой скоростью. В результате получали заготовки размерами 300×80×20.

Проведенные исследования показали, что основными примесями в исследуемых отходах tantalа являются железо, марганец, молибден и углерод. В зависимости от времени выдержки резко снижается содержание железа (в 10 раз) и молибдена

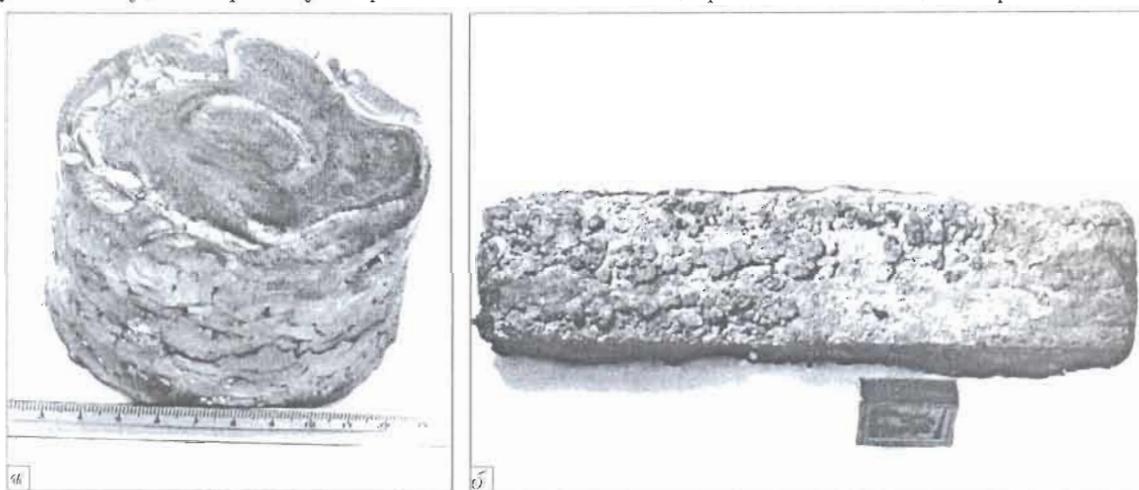


Рис. 4. Внешний вид скомпактированной заготовки из tantalа круглой (а) и плоской (б) форм



(в 2,5 раз), после переплава практически не обнаруживается марганец (таблица). Уменьшается содержание углерода (рис. 2).

Выявлено, что чем меньше тантал загрязнен примесями, тем труднее их удалить. От содержания примесей зависит и плотность металла: чем их меньше, тем выше плотность металла.

Установлено, что качество боковой поверхности скомпактированной заготовки зависит от нескольких факторов:

массы засыпки (чем меньше засыпка, тем лучше поверхность);

энергетических параметров плавки (чем больше вкладывается энергии, тем лучше качество поверхности);

качества предварительной подготовки шихты.

В целом следует отметить перспективность переработки отходов тантала способом ПДП и ее модификаций как для рафинирования от примесей, так и для формирования компактных заготовок небольшой (2...3 кг) и средней (7...11 кг) массы (рис. 4).

1. Физические величины. Справочник / А. П. Бабичев, Н. А. Бабушкина, А. М. Братковский и др. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 1231 с.
2. Козина Л. Н., Ревякин А. В., Громова М. М. Растворимость азота в жидким tantalе и ванадии // Физико-химические основы взаимодействия жидкого металла с газами и шлаками. — М.: Наука, 1978. — С. 51–64.
3. Кипарисов С. С., Левинский Ю. В. Азотирование тугоплавких металлов. — М.: Металлургия, 1972. — 160 с.
4. Ниобий и tantal / А. Н. Зеликман, Б. Г. Коршунов, А. В. Елютий, А. М. Захаров. — М.: Металлургия, 1980. — 290 с.
5. Киффер Р., Браун Х. Ванадий, ниобий, tantal / Пер. с нем.; под ред. Е. М. Савицкого. — М.: Металлургия, 1968. — 311 с.
6. Зеликман А. Н. Металлургия редких металлов. — М.: Металлургия, 1980. — 328 с.
7. Варич И. Ю., Ахонин С. В., Тригуб Н. П. Утилизация лома tantalа способом электронно-лучевой плавки // Современ. электрометаллургия. — 2005. — № 3. — С. 44–46.
8. Ахонин С. В. Эффективность рафинирования и потери на испарение при электронно-лучевой плавке tantalа // Пробл. спец. электрометаллургии. — 2000. — № 3. — С. 33–37.

Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, Киев
Поступила 04.08.2008

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСВАРКИ им. Е. О. ПАТОНА НАН УКРАИНЫ



Объявляет ежегодный набор по следующим специальностям:

ДОКТОРАНТУРА

- ❖ сварка и родственные технологии
- ❖ автоматизация технологических процессов
- ❖ металловедение и термическая обработка металлов
- ❖ металлургия высокочистых металлов и специальных сплавов

АСПИРАНТУРА

- ❖ сварка и родственные технологии
- ❖ автоматизация технологических процессов
- ❖ металловедение и термическая обработка металлов
- ❖ металлургия высокочистых металлов и специальных сплавов

Прием документов проводится в сентябре.

Контактный телефон: 289-84-11.

*Подробная информация на сайте института (раздел аспирантура): [www: paton.kiev.ua](http://paton.kiev.ua)
Документы направлять по адресу: 03680, Украина, Киев-150, ГСП, ул. Боженко, 11,*

Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, ученому секретарю